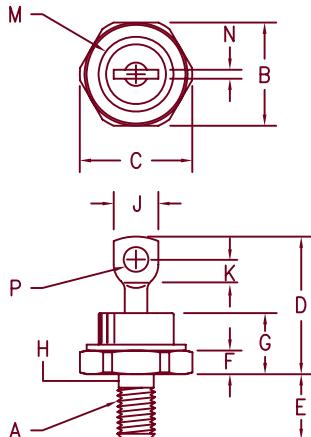


# 40 Amp Schottky Rectifier

## 1N5832 — 1N5834



Notes:

1. Full threads within 2 1/2 threads
2. Stud is Cathode.

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	---	---	---	---	1,2
B	.669	.687	16.99	17.45	
C	---	.794	---	20.17	
D	---	1.00	---	25.40	
E	.422	.453	10.72	11.51	
F	.115	.200	2.92	5.08	
G	---	.450	---	11.43	
H	.220	.249	5.59	6.32	1
J	---	.375	---	9.52	
K	.156	---	3.96	---	
M	---	.515	---	13.08	Dia
N	---	.080	---	2.03	
P	.140	.175	3.56	4.44	Dia

DO-213AB (DO-5)

Microsemi Catalog Number	Working Reverse Voltage	Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage
1N5832	20V	20V	24V	
1N5833	30V	30V	36V	
1N5834	40V	40V	48V	

- Schottky Barrier Rectifier
- Guard Ring Protection
- Low Forward Voltage
- 40 Amperes
- 125°C Junction Temperature
- $V_{RRM}$  20 to 40 Volts

### Electrical Characteristics

	1N5832	1N5833	1N5834	
Average forward current	$I_{F(A)}$	40A	40A	40A
Maximum surge current	$I_{FSM}$	800A	800A	800A
Max peak forward voltage	$V_{FM}$	.360V	.370V	.380V
Max peak forward voltage	$V_{FM}$	.520V	.550V	.590V
Max peak forward voltage	$V_{FM}$	.980V	1.080V	1.180V
Max peak reverse current	$I_{RM}$	150mA	150mA	150mA
Max peak reverse current	$I_{RM}$	20mA	20mA	20mA
Typical junction capacitance	$C_J$	2200pF	2200pF	2200pF
				$T_C = 100^\circ\text{C}$ , half sine wave, $R_{\theta JC} = 1.0^\circ\text{C}/\text{W}$
				8.3ms, half sine, $T_J = 125^\circ\text{C}$
				$ FM = 10\text{A}, TJ = 25^\circ\text{C}^*$
				$ FM = 40\text{A}, TJ = 25^\circ\text{C}^*$
				$ FM = 125\text{A}, TJ = 25^\circ\text{C}^*$
				$V_{RRM}, TJ = 100^\circ\text{C}$
				$V_{RRM}, TJ = 25^\circ\text{C}^*$
				$T_J = 25^\circ\text{C}, VR = 5\text{V}$

\*Pulse test: Pulse width 300  $\mu\text{sec}$ , Duty cycle 2%

### Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temp range	$T_{STG}$	$-65^\circ\text{C}$ to $175^\circ\text{C}$
Operating junction temp range	$T_J$	$-65^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$
Max thermal resistance	$R_{\theta JC}$	$1.0^\circ\text{C}/\text{W}$ junction to Case
Max mounting torque		30 inch pounds maximum
Typical Weight		.54 ounces (15.3 grams) typical

# 1N5832 - 1N5834

Figure 1  
Typical Forward Characteristics

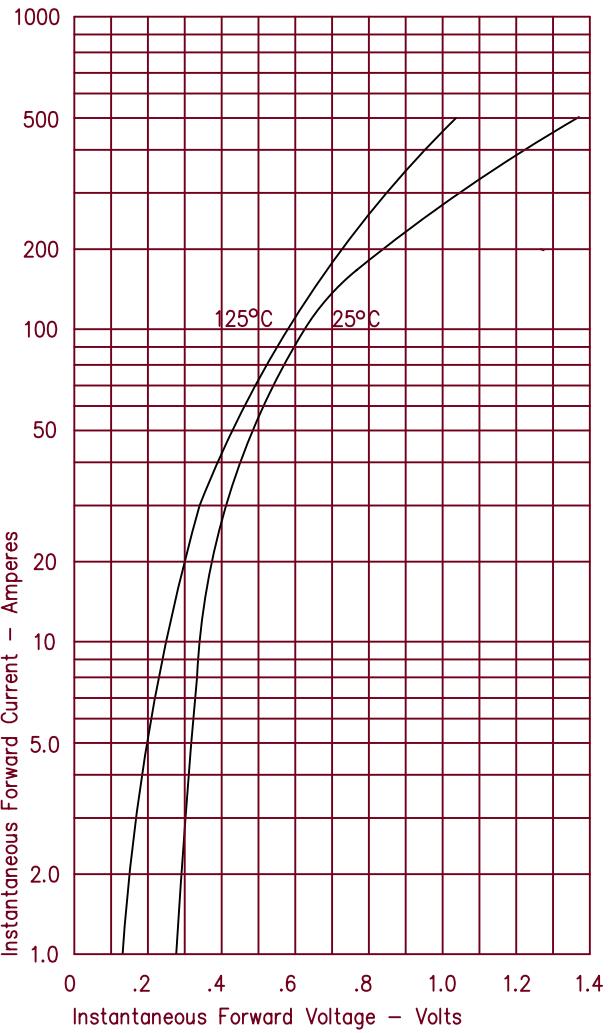


Figure 2  
Typical Reverse Characteristics

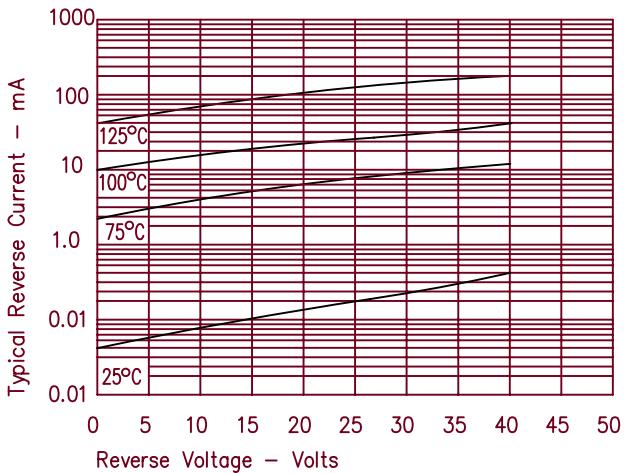


Figure 3  
Typical Junction Capacitance

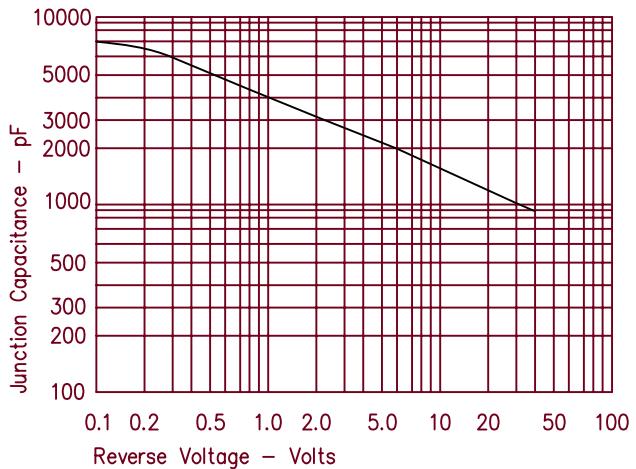


Figure 4  
Forward Current Derating

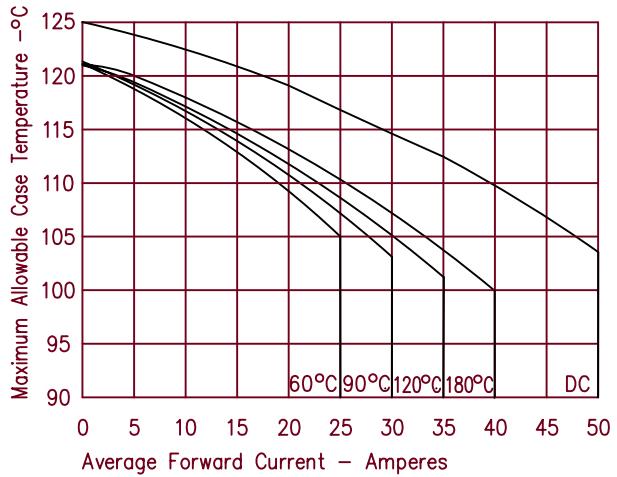
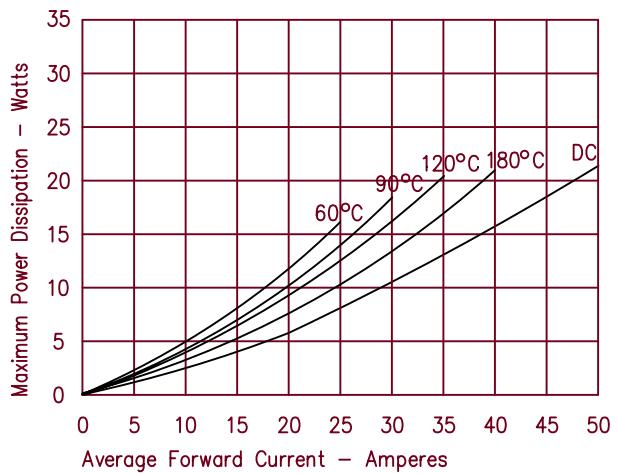


Figure 5  
Maximum Forward Power Dissipation



**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9